درس الكترونيك ٣

تمرین سری ۴

سوال اول

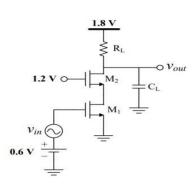
الف )مدار زیر را در نرم افزار Hspice شبیه سازی کرده ،نقطه کار ترانزیستورها ، میزان بهره ، پاسخ فرکانسی ، مکان صفر و قطب ها و سوئینگ خروجی را بیابید سپس نتایج بدست آمده را با نتایج محاسبات دستی مقایسه نمایید.

 $W_{1,2} = 360 \mu m$ 

 $L_{1,2} = 180 nm$ 

 $C_L = 10p$ 

 $R_L = 1K\Omega$ 



ب)مدار بالا را با حفظ مشخصات در صورتی که ترانزیستورها به BJT تغییر کنند ، دوباره شبیه سازی کرده و نتایج را با هم مقایسه نمایید

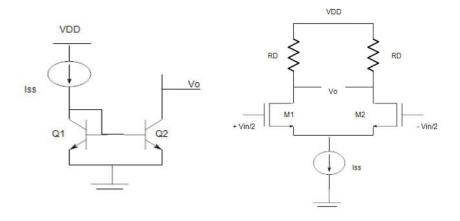
ج)در مدار اولیه بار  $R_L$  را با بار فعال ساده و کسکود جایگزین کرده و نتایج را بررسی نمایید.

سوال دوم

الف )مقدار ترانزیستورها را برای مدارهای زیر به نحوی که در ناحیه مناسب کار کنند بیابید.

RD =  $100k\Omega$  , Iss = 1mA

ب) برای مدار خود بهره ، پاسخ فرکانسی و مکان صفر و قطب ها را به کمک نرم افزار شبیه سازی نمایید.



موفق باشيد